

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年10月16日(2008.10.16)

【公開番号】特開2006-108654(P2006-108654A)

【公開日】平成18年4月20日(2006.4.20)

【年通号数】公開・登録公報2006-016

【出願番号】特願2005-260169(P2005-260169)

【国際特許分類】

H 01 L	21/822	(2006.01)
H 01 L	27/04	(2006.01)
G 06 K	19/077	(2006.01)
G 06 K	19/07	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/8234	(2006.01)
H 01 L	27/06	(2006.01)
H 01 L	27/08	(2006.01)
H 01 L	21/8238	(2006.01)
H 01 L	27/092	(2006.01)
H 01 L	27/12	(2006.01)

【F I】

H 01 L	27/04	C
G 06 K	19/00	K
G 06 K	19/00	H
H 01 L	29/78	6 1 3 Z
H 01 L	27/06	1 0 2 A
H 01 L	27/08	3 3 1 E
H 01 L	27/08	3 2 1 B
H 01 L	27/12	L

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月3日(2008.9.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

I Cチップと、前記I Cチップと少なくとも一部が重なるように設けられたアンテナと、を有する無線チップであって、

前記I Cチップと、前記アンテナと、が絶縁膜を介して重なる位置に、前記I Cチップ上に形成された配線を第1の電極とし、前記アンテナを第2の電極とする容量素子が形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項2】

請求項1において、

前記I Cチップは、集積回路と、前記容量素子と、を有し、

前記集積回路は、半導体膜と、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上に形成された第1の絶縁膜と、前記第1の絶縁膜上に形成されたソース電極およびドレイン電極と、を有し、

前記配線は、前記第1の絶縁膜上に形成され、かつ、前記ソース電極およびドレイン電極と同じ材料で形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項3】

請求項1において、

前記ICチップは、集積回路と、前記容量素子と、を有し、

前記集積回路は、半導体膜と、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上に形成された第1の絶縁膜と、前記第1の絶縁膜上に形成されたソース電極およびドレイン電極と、を有し、

前記配線は、前記ゲート絶縁膜上に形成され、かつ、前記ゲート電極と同じ材料で形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項4】

請求項1において、

前記ICチップは、集積回路と、前記容量素子と、を有し、

前記集積回路は、基板上に形成された半導体膜と、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上に形成された第1の絶縁膜と、前記第1の絶縁膜上に形成されたソース電極およびドレイン電極と、を有し、

前記配線は、前記基板上に形成され、かつ、前記半導体膜と同じ材料で形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項5】

ICチップと、前記ICチップと少なくとも一部が重なるように設けられたアンテナと、を有する無線チップであって、

前記ICチップと、前記アンテナと、が絶縁膜を介して重なる位置に、前記ICチップ上に形成された第1の配線を第1の電極とし、第1の配線上に第1の絶縁膜を介して形成された第2の配線を第2の電極とする第1の容量素子と、前記第2の配線を第1の電極とし、前記第2の配線上に第2の絶縁膜を介して形成された前記アンテナを第2の電極とする第2の容量素子が形成されていることを特徴とする無線チップ。

【請求項6】

請求項1乃至請求項5のいずれか一項において、

前記ICチップおよび前記アンテナは、同一基板上に形成されていることを特徴とする無線チップ。